



Сминтина В.А.

Смынтына Валентин Андреевич - Ректор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова с 1995, доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Дата и место рождения: 8 сентября 1948, с. Вишневое Татарбунарского района Одесской области. Образование: Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (с отличием), 1971 (физик). В 1971-1974 – аспирант кафедры экспериментальной физики университета, с 1977- кандидат, с 1988 – доктор Физико-математических наук, с 1992 – профессор. В 1992 -1995 – проректор по

международным связям и внешнеэкономической деятельности ОГУ. С 1992 – заведующий кафедрой экспериментальной физики ОГУ. Область научных интересов: физика и техника полупроводников, сенсорная электроника и технологии. Руководитель научной школы физики полупроводников в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова. Обладатель 12 авторских свидетельств на изобретения в области физики и техники полупроводников, сенсорной электроники и технологий. Автор более 300 научных работ, в том числе 5 монографий и учебных пособий, свыше 290 статей. Эксперт Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники, член Государственной аккредитационной комиссии Украины. Член Академии наук Высшей школы Украины, академик-основатель Международной академии компьютерных наук и систем. Входит в состав научного совета по сенсорным системам при Президиуме НАН Украины и научного совета по физике полупроводников НАН Украины, возглавляет секцию сенсорики; член бюро научного совета по физике Министерства образования и науки Украины (руководитель секции физики полупроводников). Член Международного программного и Европейского комитетов "Eurosensor", Европейского и Украинского физического обществ. Национальный координатор и член Европейского совета программ "Nexus". Консультант-координатор Гуманитарной международной культурной ассоциации "Италия - Украина", организатор и участник многих международных и отечественных научных конференций. Основные факты деятельности: за время работы профессора В.А. Смынтыны в должности ректора университета сформированы 3 факультета (экономико-правовой, философский и довузовской подготовки), 3 учебно-научных центра, институт, колледж, техникум. Открыты 12 новых конкурентоспособных специальностей, десять новых кафедр и пять отделений. Общая численность студентов увеличилась более чем вдвое - с 9500 до 21000 человек. Существенно возрос и научный потенциал профессорско-преподавательского состава, динамика роста количества докторов наук (с 95 до 186) и кандидатов наук (с 450 до 800). Количество аспирантов увеличилось до 520 человек. Учебный процесс в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова обеспечивают 4 института, 10 факультетов, 3 учебно-научных центра,

техникум, колледж. Научные исследования сосредоточены в 4 Научно-исследовательских институтах, 28 научных подразделениях. Среди них 8 научно-исследовательских центров, 14 проблемных и отраслевых научно-исследовательских лабораторий, астрономическая обсерватория, ботанический сад, научная библиотека с книжным фондом около 4 млн. томов, среди которых более 100 тыс. редких и ценных изданий. В 2000 г. Одесскому государственному университету присвоен статус национального. По инициативе и под руководством ректора ОНУ впервые в Украине создана разветвленная сеть учебно-научных центров в городах Николаеве, Первомайске, Ильичевске, Херсоне, Южном, Белгороде-Днестровском, Теплодаре. Открыты техникум и колледж предпринимательства и социальной работы, на базе которого (впервые в Украине) был создан региональный комплекс "Школа - Колледж - Университет". С 2002 г. В.А. Смынтына - депутат, член президиума, председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта Одесского областного совета. Профессор Международной академии Святых Апостолов Петра и Павла (г. Рим, Ватикан), почетный профессор Херсонского государственного технического университета, почетный доктор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, почетный гражданин города Очакова, почетный член Академического сената университета г. Сегед (Венгрия). Награды: кавалер орденов "За заслуги" III степени, "Золотой Крест Святых Апостолов Петра и Павла" (Ватикан), Святого Владимира IV степени; награжден золотой медалью "10 лет независимости" I степени, международной наградой им. Сократа, почетной наградой "Святая София"; знаками "Отличник образования Украины" и главы Одесской областной государственной администрации, золотой медалью Общества содействия промышленности в области науки и образования (Франция) и др.

Основные научные публикации

Статьи

2005:

1. The analytical study of a biphase cadmium selenide structural model / V. A. Smyntyna, V. S. Grinevich, V. M. Vorobel, L. N. Filevskaya // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2005. — Vol. 8, Is. 2. — P. 4-6.
2. Investigation in temperature and frequency dependences for conductivity in barrier region of nonideal heterojunction / V. A. Smyntyna, V. A. Borschak, M. I. Kutalova [and other] // *Photoelectronics*. — Odessa, 2005. — N 14. — P. 5-7.
3. Novel SnO₂ based optical sensor for detection of low ammonia concentrations in water at room temperatures. / M. Pisco, M. Consales, R. Viter, V. Smyntyna [and other] // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2005. — Vol. 8, Is. 1. — P. 95-99.
4. Photoluminescence of tin dioxide thin films, obtained with use of polymers / V. A. Smyntyna, L. N. Filevskaya, V. S. Grinevich // *Photoelectronics*. — Odessa, 2005. — N 14. — P. 42-44.
5. Structural properties of nanocrystalline tin dioxide films deposited by electrostatic spray pyrolysis method / V. Smyntyna, R. Viter, N. Evtushenko // *Photoelectronics*. — Odessa, 2005. — N 14. — P. 54-57.

6. Влияние структурных превращений на электропроводность гетерофазных слоев селенида кадмия / В.А.Смынтына, В.С.Гриневич, Л.Н.Филевская // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2005. - №5. - С.97-100.

7. Исследование механизма изменения радиационной чувствительности дозиметров поглощенной дозы ионизирующего излучения на основе структур металл – диоксид кремния – кремний / В.А. Смынтына, О.А. Кулинич, М.А. Глауберман, Г.Г. Чемересюк, И.Р. Яцунский // Сенсор.- 2005. - № 4 (17). – С. 18 – 22.

8. Источники ионно-зависимой нестабильности параметров сенсорных кремниевых МОП-структур / В.А. Смынтына, О.А. Кулинич // Сенсор.- 2005. - № 5 (17). – С. 40 – 44.

9. Моделирование процесса токопереноса в реальной полевой приборной структуре диоксид кремния - кремний с инверсионным каналом / В.А. Смынтына, О.А. Кулинич // Сенсор.- 2005. - № 2 (17). – С. 49 – 53.

10. Моделювання процесу струмопереносу в реальних структурах метал – кремній з бар'єром Шоткі / В.А.Сминтина, О.А. Кулініч, М.А. Глауберман, Г.Г. Чемересюк, І.Р. Яцунський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. - Т.6, №4. - С. 656 – 660.

11. Отримання та властивості наноструктурованих плівок SnO₂, отриманих з використанням полімерів / В.А.Сминтина, В.С.Гриневич, Л.Н.Філевська // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Фізика. Електроніка - 2005. - Вип.237. - С.72-76.

2006:

1. Current flow process simulation in metal — silicon structures / V. Smyntyna, O. Kulinich, M. Glauberaman [and other] // Photoelectronics. Odessa, 2006. — N 15. — P. 84–88.

2. Image sensor on the basis of nonideal heterojunction with rigid raster / V. Smyntyna, V. Borshak, M. Kutalova [and other] // Photoelectronics. — Odessa, 2006. — N 15. — P. 21–23.

3. Influence of matrix photoluminescence of CdS nanocrystals / V. Smyntyna, V. Skobeeva, N. Malushin, A. Pomogailo // Photoelectronics. — Odessa, 2006. — N 15. — P. 38–42.

4. Methods to increase conductivity of polymers in conductive polymer / CdS semiconductor nanocrystal structures / V. Smyntyna, Chebanenko, A. Aleksandrov // Photoelectronics. — Odessa, 2006. — N 15. — P. 69–72.

5. Morphology of nanostructured SnO₂ films prepared with polymers employment / V. Smyntyna, L. Filevskaya, V. Grinevich // Photoelectronics. — Odessa, 2006. — N 15. — P. 11–14.

6. A Novel Optochemical Sensor Based on S. O. Sensitive Thin Film for ppm Ammonia Detection in Liquid Environment / V. Smyntyna, M. Pisco, M. Consales // Journal of light wave technology. — 2006. — Vol. 24, N 12. — P. 5000–5007.

7. Optochemical sensor for water monitoring based on SnO₂ particle layer deposited onto optical fibers by the electrospray pyrolysis 190 method. / V. Smyntyna, A. Cusano, M. Consales, [and other] // Applied Physics Letters. — 2006. — Vol. 89, Issue 11. — P. N.PAG, (3p, 2 diagrams, 2 graphs).

12. Влияние адсорбции биологических молекул на электронные параметры пористого кремния / В.А.Смынтына, Ю.А.Вашпанов, И.П.Конуп, В.А.Иваница // Вісн.Одеського нац. ун-ту. — 2006. —т.11, Вып7: Физ-мат науки —С.39-46

13. Влияние дефектов на распределение концентрации легирующей примеси по пластине монокристаллического кремния / В.А. Смынтына, О.А. Кулинич, М.А. Глауберман, Г.Г. Чемересюк, И.Р. Яцунский // Сенсор. – 2006. - № 3 (21). – С. 19 – 23.

2007-2009:

1. Effect of photocurrent shortwave stimulation and determination of diffusion length for minority carriers in Cu₂S / V. Smyntyna, V. Borshak, M. Kotalova [and other] // Photoelectronics. — Odessa, 2007. — N 16. — P. 23–25.

2. The nature of emission centers in CdS nanocrystals. / V. Smyntyna, V. Skobeeva, N. Malushin // Radiation Measurements. — 2007. — Vol. 42, Is. 4/5 (Apr.). — P. 693–696.

3. Optical absorption and electronic system parameters of N. N. SnO₂ films / V. Smyntyna, L. Filevskaya, V. Grinevich // Photoelectronics. — Odessa, 2007. — N 16. — P. 49–52.

4. Вплив дефектів на розподіл концентрації легуючої домішки та дефектоутворення при легуванні кремнію / В.А.Сминтина, О.А. Кулініч, М.А. Глауберман, Г.Г. Чемересюк, Е.Т. Роговська, І.Р. Яцунський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2007. -Т.8, №4. – С. 698 – 702.

5. The structure investigation of near surface layers in silicon – dioxide silicon structure / Smyntyna V. A. , Kulinich O. A. Chemeresuk G. G., Yatsunskiy I. R. // Photoelectronics. – 2008. – N 17. – P. 61- 63.

6. Influence of impurities and dislocations on the value of threshold stresses and plastic deformations in silicon / V.A. Smyntyna, O.V. Sviridova // Photoelectronics. – 2009. – № 18. – P. 52 – 56.

7. Influence of initial defects on defect formation process in ion doped silicon / V.A. Smyntyna, O.V. Sviridova // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2009. – Vol. 12, № 2. – P. 110 – 115.

8. Dependence of conductivity space-charge region nonideal heterojunction on conditions of photoexcitation / V.A. Borschak, M.I.Kotalova, N.P.Zatovskaya, A.P. Balaban, V.A.Smyntyna. // Photoelectronics.-2009.-№18. -P. 33-35.

9. Spectroscopy of polarized and modulated light for nanosized tin dioxide films investigation / Maximenko L.S.,Matyash I.E., Rudenko S.P., Serdega B.K., Grinevich V.S., Smyntyna V.A., Filevskaya L.N. // Photoelectronics. N 18, 2009. Odessa: Astroprint. – P. 24-27.

10. Оптические свойства нанокристаллов сульфида кадмия, полученных золь-гель методом в желатиновой матрице / В.А.Смынтына, В.М.Скобеева, О.И.Свиридова // Журнал прикладной спектроскопии. - 2008. - т.75, №4. - С.556-562.

11. Электрофизические проявления структурных преобразований в слоях селенида кадмия / В.А.Смынтына, В.М.Воробель, В.С.Гриневич // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2008. - №10. - С.1-6.